



Caratteristiche $I_D - V_{GS}$ per transistor MOSFET ad arricchimento di tipo n (a destra) e di tipo p (a sinistra) in saturazione ($V_{TH} = 1$ V per l'NMOS e -1 V per il PMOS, $k_n (W/L) = 0.5 \text{ mA/V}^2$). Per $V_{GS} = V_{TH}$ la corrente I_D è teoricamente nulla; in pratica, in un dispositivo discreto è dell'ordine del μA , mentre quella per $V_{GS} = 0$, detta I_{DSS} è dell'ordine del $n\text{A}$.